MG020201

特長

- ●小型 DIP パッケージ
- ●絶縁タイプ
- ●高耐圧
- ●高放熱性

用途

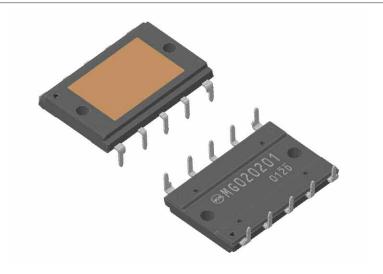
- ●汎用インバータ
- ●サーボアンプ

Feature

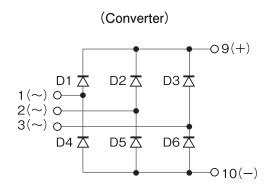
- Small DIP Package
- Isolated Packag
- High Voltage
- High Heat Dissipation

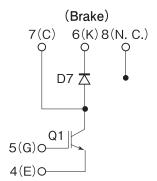
Application

- Inverter
- Servo Amplifier

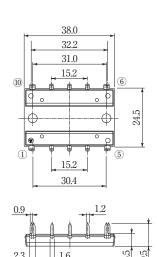


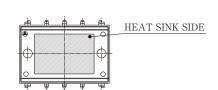
■電極図 TERMINALS

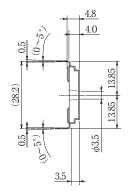


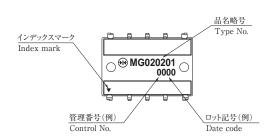


■外観図 OUTLINE









■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25℃/unless otherwise specified)

コンバータ部/Converter

ダイオード / Diode

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj		150	$^{\circ}$ C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		600	V
非繰り返しせん頭サージ逆電圧 Non-Repetitive Peak Surge Voltage	V _{RSM}		800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波,抵抗負荷,Tc=136℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Tc=136℃	30	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波,非繰り返し1 サイクルせん頭値,Tj=25℃,一素子当たりの規格値 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃, Rating of per diode	300	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	lms ≦ t < 5ms, Tj=25℃, 一素子当たりの規格値 1ms ≦ t < 5ms, Tj=25℃, Rating of per diode	300	A ² s

最大瞬間接合部温度は 150 $^{\odot}$ (at $T_{\rm C} \le 136$ $^{\odot}$) ですが、安全動作させるための平均動作接合部温度は $T_{\rm J} \le 125$ $^{\odot}$ (at $T_{\rm C} \le 111$ $^{\odot}$) のご使用ください。

ブレーキ部/Brake

IGBT

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	$^{\circ}$ C
コレクタ・エミッタ電圧 Collector-Emitter Voltage	Vces		600	V
ゲート・エミッタ電圧 Gate-Emitter Voltage	V _{GES}		± 20	V
コレクタ電流(直流) Continuous Collector Current (DC)	Ic		30	A
コレクタ電流(ピーク) Continuous Collector Current (Peak)	Icp	パルス幅 10μs, duty=1/100 Pulse width 10μs, duty=1/100	60	A
全損失 Total Power Dissipation	Рт		178	W

ブレーキ部/Brake

ダイオード / Diode

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj		150	${\mathbb C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{\rm RM}$		600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波,抵抗負荷,Tc = 137℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Tc=137℃	3	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波,非繰り返し 1 サイクルせん頭値,Tj = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	90	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	lms ≦ t < 5ms, Tj=25℃, 一素子当たりの規格値 1ms ≦ t < 5ms, Tj=25℃, Rating of per diode	28	A ² s

最大瞬間接合部温度は 150 $^{\circ}$ $^{\circ}$ (at $Tc \le 137$ $^{\circ}$)ですが、安全動作させるための平均動作接合部温度は $Tj \le 125$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ (at $Tc \le 112$ $^{\circ}$)でご使用ください。

モジュール共通/Module

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-40~125	\mathbb{C}
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	ー括端子・ケース間、AC 1 分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	主端子・取付用(推奨値:0.8N·m) Main terminal fitting part (Recommended torque: 0.8N·m)	1.5	N·m

■定格表 RATINGS

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25℃/unless otherwise specified)

コンバータ部/Converter

ダイオード/Diode

項目	記号	条件		規格値 Ratings		
Item	Symbol	Conditions		TYP	MAX	Unit
順電圧 Forward Voltage	V_{F}	$I_F\!=\!10$ A, パルス測定,一素子当たりの規格値 Pulse measurement, Rating of per diode	_	_	1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R\!=\!600V$, パルス測定,一素子当たりの規格値 Pulse measurement, Rating of per diode	_	_	10	μΑ

ブレーキ部/Brake

IGBT

項目	記号	条 件		值 Ra	tings	単位
Item	Symbol	Conditions	MIN	TYP	MAX	Unit
コレクタ・エミッタ降伏電圧 Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CES}$	$I_C = 1 \text{mA}$, $V_{GE} = 0 \text{V}$	600	_	_	V
コレクタ遮断電流 Zero Gate Voltage Collector Current	Ices	$V_{CE} = 600V$, $V_{GE} = 0V$	_	_	10	μΑ
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	Iges	$V_{GE}=\pm 20V,V_{CE}\!=\!0V$	_	_	±1	μΑ
コレクタ・エミッタ間オン電圧 Static Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE} (sat)	$I_C = 30A, V_{GE} = 15V$	_	2	2.8	V
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V_{TH}	$I_C = 1 \text{mA}$, $V_{CE} = 10 \text{V}$	5.0	6.5	8.0	V
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Qg	$V_{\text{CC}} = 400 \text{V}, \; V_{\text{GE}} = 15 \text{V}, \; I_{\text{C}} = 30 \text{A}$	_	62	_	nC
入力容量 Input Capacitance	Cies	V _{CE} = 25V, V _{GE} = 0V, f = 1MHz		1670	_	
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	Cres			20	_	рF
出力容量 Output Capacitance	Coes			165	_	
ターンオン遅延時間 Turn-on Delay Time	td(on)		_	63	_	
上昇時間 Rise Time	tr	$I_C = 30 A, V_{CC} = 300 V, L = 100 \mu H,$ $V_{GE} = 15 V, V_{GE} = 15 V, R_G = 50 \Omega$		57	_	no
ターンオフ遅延時間 Turn-off Delay Time	td (off)			91	_	ns
降下時間 Fall Time	tf		_	47	_	

ブレーキ部/Brake

ダイオード/Diode

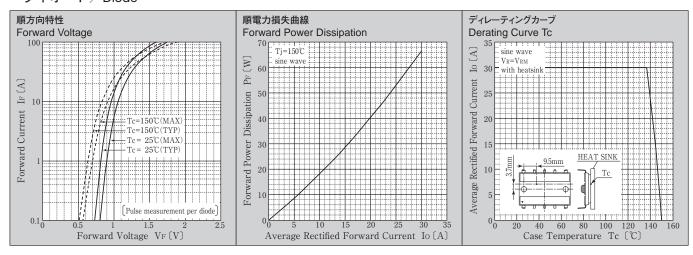
項目	記号	条件		規格値 Ratings			
Item	Symbol	Conditions	MIN	TYP	MAX	単位 Unit	
順電圧 Forward Voltage	V_{F}	$I_F = 3A$, パルス測定 Pulse measurement	_	_	1.65	V	
逆電流 Reverse Current	I_R	$ m V_R$ = $600 m V$, パルス測定 Pulse measurement	_	_	10	μΑ	
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5 A, \ I_R = 1.0 A, \ 0.25 I_R$		_	50	ns	

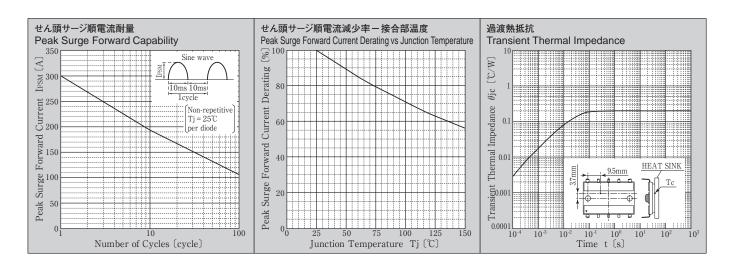
モジュール共通/Module

項目	記号	条 件 Conditions			規格値 Ratings			単位
Item	Symbol				MIN	TYP	MAX	Unit
熱抵抗 Thermal Resistance		接合部・ケース間 Junction to case	コンバータ部 Converter	Diode	_	_	0.2	
			ブレーキ部	IGBT	_	_	0.7	°C/W
			Brake	Diode	_	_	2.4	

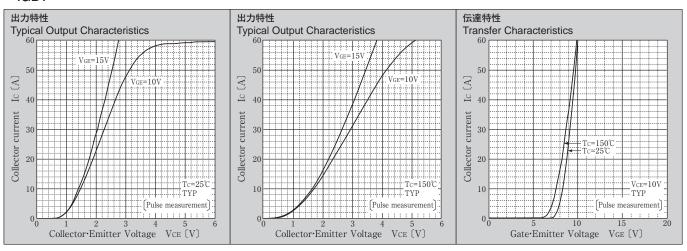
■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

コンバータ部/Converter ダイオード/Diode

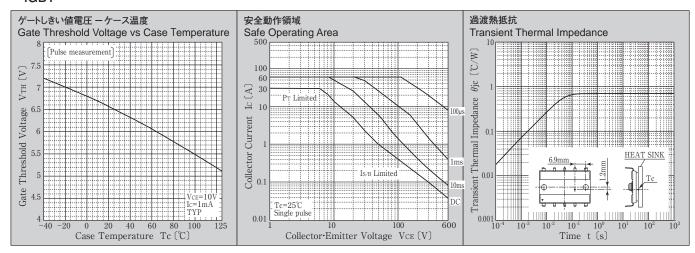


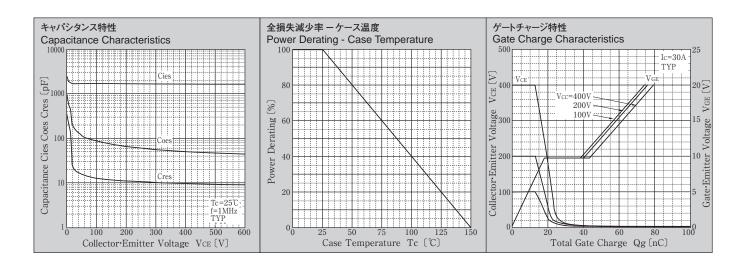


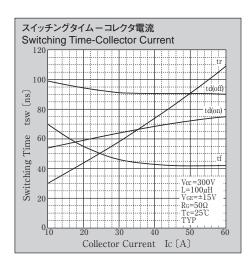
ブレーキ部/Brake IGBT



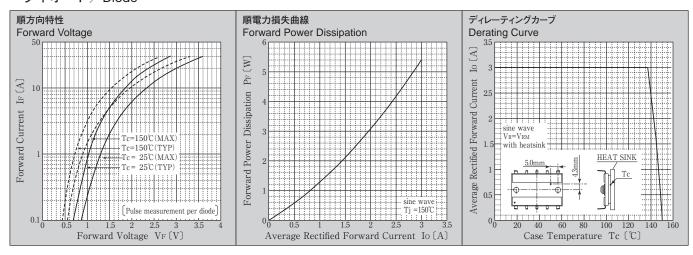
ブレーキ部/Brake IGBT

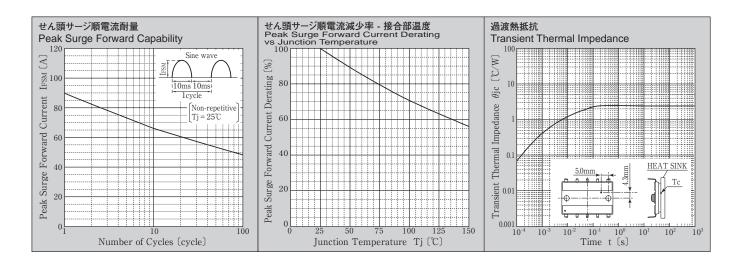






ブレーキ部/Brake ダイオード/Diode





ご注意

- 1. ご採用に際しては、別途仕様書をご請求の上、ご確認をお願いいたします。
- 2. 本資料に記載されている当社製品の品質水準は、一般的な信頼度が要求される標準用途を意図しています。 その製品の故障や誤動作が直接生命や人体に影響を及ぼすような極めて高い品質、信頼度を要求される特別、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず事前に当社へご連絡の上、確認を得て下さい。 当社の製品の品質水準は以下のように分類しております。

【標準用途】

コンピュータ、OA 等の事務機器、通信用端末機器、計測器、AV 機器、アミューズメント機器、家電、工作機器、パーソナル機器、産業用機器等

【特別用途】

輸送機器(車載、船舶等)、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療機器等

【特定用途】

原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、生命維持のための装置、システム 等

- 3. 当社は品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご検討下さい。
- 4. 本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。製品のご購入に際しましては事前に当社または特約店へ最新の情報をご確認下さい。
- 5. 本資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負いません。
- 6. 本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 7. 本資料に記載されている製品が、外国為替及び外国貿易管理法に基づき規制されている場合、輸出には同 法に基づ〈日本国政府の輸出許可が必要です。
- 8. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。

